

بررسی و شبیه سازی بلورهای فوتونی سه بعدی اپال و اپال وارون دی اکسید سیلیسیوم بهینه شده و سنتز پلی استایرن با کنترل مشخصه ترمودینامیکی

ساره امیدواری^۱، آذر دخت مظاهری^۱، سید محمد حسین امین جواهری^۲، سید محمد رضا موسوی^۳، محمد مهدوی^۳

^۱مجتمع علوم کاربردی مالک اشتر، دانشکده فیزیک، اصفهان، شاهین شهر

^۲مجتمع علوم کاربردی مالک اشتر، مرکز اپتوالکترونیک، اصفهان، شاهین شهر

^۳مجتمع علوم کاربردی مالک اشتر، دانشکده شیمی، اصفهان، شاهین شهر

چکیده - در این مقاله ساختارهای بلور فوتونی سه بعدی اپال و اپال وارون هوا در SiO_2 شبیه سازی شده اند و به منظور داشتن گاف نواری بسامدی پهن، بهینه سازی گردیده اند. سپس با توجه به شعاع بهینه کره های هوا، ویژگی ساختار بلور فوتونی اپال متشکل از کره های پلی استایرن در هوا شبیه سازی شده است. در انتها، با تهیه اپال به روش سل-ژل، ذرات هم اندازه و با شعاع بهینه شده ای بدست آمدند که تصویر SEM آنها مشابه نتایج شبیه سازی به دست آمده است.

کلید واژه- اپال، اپال وارن، بلور فوتونی سه بعدی پلی استایرن، گاف نواری بلور فوتونی

Investigation and simulation of the optimized three-dimensional opal and inverse opal of SiO_2 photonic crystals and synthesis of Polystyrene by controlling the thermodynamic property

Mazaheri, Azardokht¹; Omidvari, Sareh¹; Amin Javaheri, Seyed mohammad hossein²;

Mousavi, Seyed mohammad reza¹; Mahdavi, Mohammad³

¹ Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Physics, Isfahan, Shahin Shahr

² Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Optoelectronic Center, Isfahan, Shahin Shahr

³ Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Chemistry, Isfahan, Shahin Shahr

Abstract- In this paper, three-dimensional photonic crystal structures of air inverse-opal and opal in the SiO_2 is simulated and structures are optimized in order to have a wide frequency band gap. Using the optimal radius of air spheres, characteristic of the opal photonic crystal made of polystyrene spheres in air is simulated. Finally we are produced opal by sol-gel method obtained particles with optimal radius and equal size that their SEM images are similar to the simulation results.

Keywords: Opal, Inverse-opal, Polystyrene three-dimentional photonic crystal, Photonic crystal band gap.

۱- مقدمه

در آن میدان مغناطیسی با استفاده از تئوری بلخ برحسب امواج تخت بسط داده شده و با بسط ثابت دی الکتریک در فضای شبکه وارون، معادله موج حاصل از معادلات ماکسول در فضای فرکانس (ω) و فضای بردار موج (k) به دست می آید. در نهایت معادله حاصل به روش های عددی حل شده و به این ترتیب وابستگی ω به k به دست می آید [۵].

این روش بر اساس بسط فوری و تابع دی الکتریک است و با توجه به معادلات الکترومغناطیس ماکسول، معادله میدان مغناطیسی به صورت معادله (۱) به دست می آید [۴].

$$\nabla \times \left(\frac{1}{\epsilon(\vec{r})} \nabla \times H(\vec{r}) \right) = \left(\frac{\omega}{c} \right)^2 H(\vec{r}) \quad (1)$$

فرض می شود که محیط مادی، همگن و همسانگرد است و ثابت دی الکتریک مستقل از بسامد در نظر گرفته می شود. در نتیجه میدان مغناطیسی و ثابت دی الکتریک بر حسب امواج تخت مطابق معادله های (۲) خواهند شد.

$$\begin{aligned} H(\vec{r}) &= \sum_{\vec{G}} H(\vec{G}) \exp\{i(\vec{k} + \vec{G}) \cdot \vec{r}\} \\ D(\vec{r}) &= \sum_{\vec{G}} k(\vec{G}) \exp(i\vec{G} \cdot \vec{r}) \end{aligned} \quad (2)$$

با مشخص کردن $k(\vec{G})$ و حل معادلات بالا برحسب G های مختلف، بسامد متناظر با هر بردار موج تعیین و بدین ترتیب ساختار نواری به دست می آید.

۳- طراحی و شبیه سازی

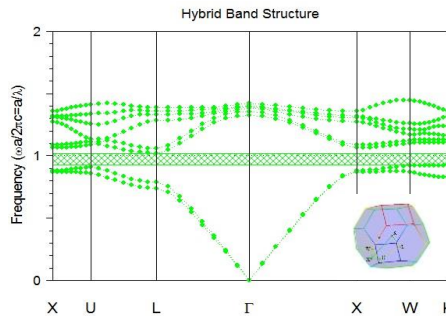
ساختار اپال وارون اکسید سلیسیوم، یک ساختار بلور فوتونی سه بعدی و متشکل از آرایه ای از کره های هوا در زمینه اکسید روی با ساختار مکعبی مرکز پر (FCC) است. در این پژوهش با توجه به ضریب دی الکتریک اکسید سلیسیوم در ناحیه مرئی که $1/459 - 1/457$ است، با استفاده از روش بسط موج تخت (PWE) شبیه سازی شد. شکل ۱ طراحی ساختار سه بعدی اپال وارون را نشان می دهد (شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Rsoft صورت گرفته است). در این شبیه سازی اثر تغییر شعاع کره های هوا و اختلاف ضریب دی الکتریک بین ماده و محیط برای داشتن گاف نواری کامل در تمامی نواحی بسامدی بررسی شد.

بلورهای فوتونی، مواد اپتیکی مصنوعی هستند که امکان کنترل نور را فراهم می کنند. ساختار بلور فوتونی، آرایه منظم و متناوب از دو یا چند ماده با ضریب شکست متفاوت است به گونه ای که تغییرات در ضریب شکست می تواند در یک، دو یا سه بعد تکرار شود. همان گونه که مواد نیم رسانا با پتانسیل الکترونی متناوب سبب ایجاد نوار ممنوعه در انرژی الکترون ها می گردند، ساختارهای بلور فوتونی نیز سبب ایجاد نوارهای بسامدی و گاف نوار بسامدی می شوند. طول دوره تناوب این ساختارها را ثابت شبکه می نامند که با ثابت شبکه معمولی اتم ها قابل مقایسه است [۱،۲]. امروزه بلورهای فوتونی به دلیل توانمندی گسترده در سیستم های نوری نوین نقش مهمی را ایفا می کنند [۵-۳]. پاشندگی نور از بلور فوتونی (ساختار اپال) می تواند باعث ایجاد فلاش هایی با هر کدام از رنگ های رنگین کمان شود. منشاقوس و قزح در اپال ها ناشی از ریز ساختارهایی است که به طور منظم کنار هم قرار گرفته اند و باعث می شوند که نور از صفحات کره ها پاشیده شود و همچنین اندازه قطر و فاصله کره ها، بر بسامد نور مشاهده شده تاثیر می گذارد. طول موج نور پاشیده شده از این ساختار، چند صد نانومتر است و در ناحیه طول موج های مرئی قرار می گیرد. تولید اپال ها به آن دلیل حائز اهمیت است که مرحله ای برای تولید محصول اپال وارون (یک بلور فوتونی سه بعدی با گاف نواری کامل) است [۶]. ساختار اپال وارون به دلیل خواص اپتیکی آن به عنوان ابر منشور و ابر عدسی استفاده می شود و همچنین در سلول های خورشیدی به منظور افزایش استخراج نور و افزایش بازدهی نور به کار می رود.

در این مقاله، با توجه به ضریب دی الکتریک متفاوت دو محیط و شعاع مختلف، به بررسی ساختار بلور فوتونی اپال و اپال وارون پرداخته می شود و پارامترهای وابسته به آن تحلیل و شبیه سازی می گردد.

۲- مبانی نظری

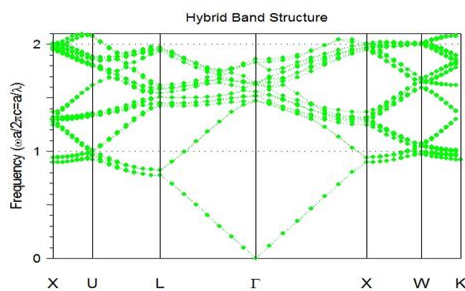
به منظور دستیابی به ساختار نواری، محیط های متناوب با ضریب دی الکتریک مختلف بررسی و به منظور به دست آوردن ساختار نواری در محیط های متناوب، روش های مختلفی ارائه شده است که متداول ترین آن روشی است که



شکل ۳: نمودار گاف نواری اپال وارون را برای شعاع بهینه و اختلاف ضریب دی الکتریک $1/459$ بین کره‌های اپال و محیط پس زمینه نشان می‌دهد.

۴- طراحی و شبیه‌سازی ساختار اپال

اپال‌ها دارای ساختار متناوب از کره‌های پلی استایرن (PS) به صورت شبکه FCC هستند. کره‌های PS در ناحیه مریی دارای ضریب شکست $1/37$ تا $1/52$ هستند که در هوا واقع شده‌اند و شعاع بهینه آن‌ها، مطابق آنچه در بخش قبل به‌دست‌آمد، $0/38$ است.

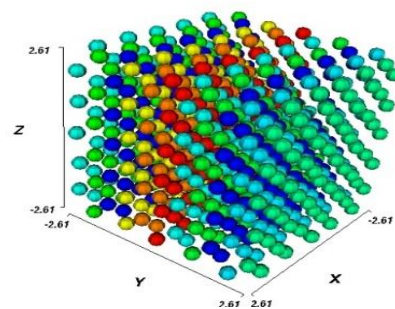


شکل ۴: نمودار گاف نواری اپال برای شعاع بهینه

مشاهده می‌گردد برخلاف اپال وارون که گاف نواری کامل دارد این ساختار گاف نواری کامل نشان نمی‌دهد.

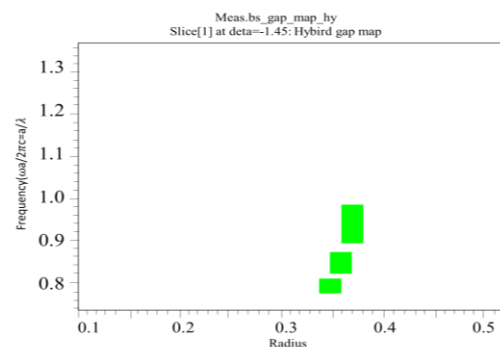
۵- سنتز پلی استایرن

روش ساخت: پلی استایرن (PS) با استفاده از پلیمریزاسیون رشد زنجیره‌ای رادیکال آزاد، ساخته می‌شود. کره‌های PS دارای اندازه‌های یکنواخت هستند و با استفاده از پلیمریزاسیون مونومر (PS) در آب تهیه می‌شوند. از آن‌جا که مونومر استایرن در آب قابل حل نیست، باید آن را به‌وسیله فرآیندی به نام پلیمریزاسیون امولسیون، پلیمریز کرد. در اینجا امولسیون به معنای سوسپانسیون قطرات روغن در آب است [۸ و ۷]. برای شروع پلیمریزاسیون به یک آغازگر نیاز است، دی بنزوئیل پراکساید به‌عنوان یک آغازگر مولکولی است که می‌تواند جزئی از واکنش را تشکیل دهد. آب



شکل ۱: طراحی ساختار سه بعدی اپال وارون

شبیه‌سازی برای ساختار اپال وارون با ضریب دی الکتریک $1/459$ برای زمینه و ضریب دی الکتریک ۱ برای کره‌های هوا برای شعاع‌های $0/34a$ تا $0/38a$ انجام شده است و نمودار گاف نواری آن در شکل ۲ رسم شده است. شکل ۳ یک گاف نواری باریک بین $0/92a/\lambda$ تا $1/03a/\lambda$ را نشان می‌دهد (a دوره تناوب شبکه است). سپس برای بهینه نمودن ساختار، شبیه‌سازی برای شعاع‌های مختلف کره‌ها در ساختار اپال وارون انجام شد و مشاهده گردید که تنها برای کره‌های هوا با شعاع بین $0/34a$ تا $0/38a$ ساختار دارای گاف نواری است. بنابراین اساس طراحی و شبیه‌سازی را برای شعاع بهینه $0/38a$ قرار داده‌ایم. در نمودار شکل ۳ شعاع بهینه و اختلاف ضریب دی‌الکتریک $1/459$ در نواحی بسامدی گاف نواری مشاهده می‌گردد.



شکل ۲: گاف نواری به ازای شعاع‌های مختلف برحسب a. اختلاف ضریب دی الکتریک بین اپال‌های وارون و محیط پس زمینه در نمودار $1/459$ است.

نمودار شعاع بهینه با اختلاف ضریب دی الکتریک $1/459$ رسم شد همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود در تمام نواحی بسامدی گاف نواری داریم.

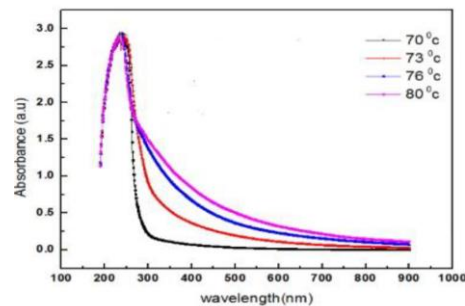
هوا، مشاهده گاف نواری کامل در تمامی نواحی بسامدی ممکن نیست. پس از محاسبات و بهینه‌سازی به روش بسط موج تخت، شعاع 0.38λ برای اپال‌های وارون و اختلاف ضریب دی‌الکتریک $1/459$ میان اپال و محیط به‌منظور ایجاد ساختار بلورفوتونی سه بعدی با گاف نواری کامل به دست آمد. برای داشتن ضریب دی‌الکتریک مورد نظر، از ترکیب SiO_2 که دارای ضریب دی‌الکتریک بزرگ‌تری نسبت به کره‌های اپال است برای دست‌یابی به گاف نواری کامل استفاده شد. داده‌های تجربی حاصل از ساخت اپال با داده‌های شبیه‌سازی کاملاً سازگاری دارند. با توجه به نتایج به‌دست آمده با افزایش دما، شاهد افزایش اندازه ذرات هستیم و از طرفی نیز با افزایش دما، جابه‌جایی قرمز حاصل شد. در نتیجه می‌توان جابه‌جایی قرمز را به‌عنوان معیاری برای سنجش اندازه ذرات به‌کار گرفت.

مراجع

- [1] H. Zhang, Photonic band gap of three dimensional magnetized photonic crystal with Voigt configuration, The European Physical Journal D, 67(8): p. 1-13. 2013.
- [2] B. Holland, C. Blanford, A. Stein, Synthesis of macroporous minerals with highly ordered three-dimensional arrays of spheroidal voids, Science 281(5376): p. 538-540, 1998.
- [3] B. Rezaei, Optimization of Q-factor in direct-coupled cavity-waveguide photonic crystal structures, Optic-International Journal for Light and Electron Optics, 124(24): p. 7056-7061, 2013.
- [4] W. Wei, Designing of High Performance Photonic Crystal Filter with two channels, in Industrial Electronics (ISIE), International Symposium on IEEE, 2012.
- [5] H. Shen, S. Banerjee, D. Klotzkin, Wavelength Division Multiplexer Based on Photonic Crystal Filters Integrated into Silicon-on-Insulator Waveguides, in Information Photonics, Optical Society of America, 2005.
- [6] V. Rybin, I. Shishkin, Band structure of photonic crystal fabricated by two-photon polymerization, journal Crystal vol. 5 (2015) 61-73.
- [7] J. Joannopoulos, Photonic crystals: molding the flow of light: Princeton university press, 2011.
- [8] A. Stein, R. Schrodin, Colloidal crystal templating Of three-dimensionally ordered Macroporous solids: materials for photonics and beyond. Current Opinion, in Solid State and Materials Science, 5(6): p. 553-564. 2001.

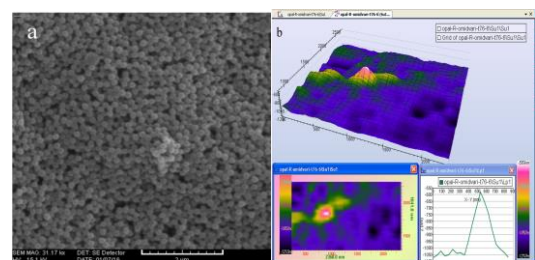
دوبار یونیزه، مونومر و دی بنزوئیل پراکساید به صورت محلول در آمده و مخلوط در مدت ۹۰ دقیقه با دماهای ۸۰ و ۹۰ درجه سنتز می‌شود. بعد از اتمام زمان سنتز، ساختارهای اپال تشکیل می‌گردد.

نمودار جذب UV، برای دماهای مختلف در شکل ۵ رسم شده است.



شکل ۵: جذب UV برای دماهای مختلف

تصویر SEM و STM حاصل از ساختار سنتز شده به ترتیب در شکل‌های ۶-ا و ۶-ب قابل مشاهده است. آشکار است که اندازه کره‌ها با توجه به دمای سنتز تغییر می‌کند.



شکل ۶: (a) تصویر SEM از ساختار کره‌های اپال سنتز شده در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد (اندازه ذرات ۲۰۰ nm)، (b) تصویر STM حاصل از نمونه سنتز شده در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد (اندازه ذرات در حدود ۳۵۰ nm)

۶- بحث و نتیجه‌گیری

بلورهای فوتونی مانند مواد دی‌الکتریک دارای گاف نواری هستند. با استفاده از گاف نواری بسامدی، می‌توان نور را در این نوع ادوات کنترل نمود. یکی از عوامل موثر در میزان پهنای گاف نواری، اختلاف ضریب دی‌الکتریک‌های محیط‌های مختلف است و هرچه میزان این اختلاف بیش‌تر باشد پهنای گاف نواری نیز افزایش می‌یابد. مواد اپال دارای ضریب دی‌الکتریک کم‌تر از ۲ هستند، از این رو به‌دلیل اختلاف کم میان ضریب دی‌الکتریک کره‌های اپال و محیط